

КТ817 n-p-n кремниевый биполярный транзистор

Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы. Предназначены для использования в ключевых и линейных схемах, блоках и узлах радиоэлектронной аппаратуры широкого применения.

Зарубежные прототипы

- Прототип KT817Б BD233
- Прототип KT817B BD235
- Прототип KT817Г BD237



- Диапазон рабочих температур корпуса от 60 до + 150°C
- Комплиментарная пара КТ816



• aAO. 336.187 ТУ / 02

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-27 (ТО-126) КТ817А, Б, В, Г
- пластмассовый корпус КТ-89 (DPAK) КТ817А9, Б9, В9, Г9





Назначение выводов

Вывод (корпус КТ-27)	Назначение (корпус КТ-27)	Вывод (корпус КТ-89)	Назначение (корпус КТ-89)	
Nº1	Эмиттер	Nº1	База	
Nº2	Коллектор	Nº2	Коллектор	
Nº3	База	Nº3	Эмиттер	



Таблица 1. Основные электрические параметры КТ817 при $T_{\text{окр. среды}}$ = 25 °C

Обозна- чение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Uкэо гр.	В	Iэ=0,1A, tи=0,3 - 1 мс		
			25	-
			45	-
			60	-
			80	
Ікбо	мкА			
		Uкэ=40 B	-	100
		Uкэ=45 B	-	100
		Uкэ=60 B	-	100
		Uкэ=100 B	-	100
Ікэг	мкА			
		Uкэ=40 В, Rбэ≤ 1 кОм	-	200
		Uкэ=45 B, Rбэ≤ 1 кОм	-	200
		1	-	200
		Uкэ=100B, Rбэ≤ 1 кОм	-	200
h ₂₁₉		Uкб=2 B, Iэ=1A	25	275
Окэ нас	В	Ік=1 А, Іб=0,1А	-	0,6
	чение	чение Uкэо гр. В Iкбо мкА Iкэг мкА	Чение В Iэ=0,1A, tи=0,3 - 1 мс Ікбо мкА Uкэ=40 В Uкэ=45 В Uкэ=60 В Uкэ=100 В Ікэг мкА Uкэ=40 В, Rбэ≤ 1 кОм Uкэ=45 В, Rбэ≤ 1 кОм Uкэ=45 В, Rбэ≤ 1 кОм Uкэ=60 В, Rбэ≤ 1 кОм Uкэ=100B, Rбэ≤ 1 кОм Uкэ=100B, Rбэ≤ 1 кОм Uкб=2 В, Iэ=1A	Чение В Iэ=0,1A, tи=0,3 - 1 мс Икэо гр. В Iэ=0,1A, tи=0,3 - 1 мс 25 45 60 80 В - Iкбо МкА - Икэ=40 В - - Икэ=60 В - - Икэ=100 В - - Икэ=45 В, Rбэ≤ 1 кОм - - Икэ=60 В, Rбэ≤ 1 кОм - - Икэ=60 В, Rбэ≤ 1 кОм - - Икэ=100В, Rбэ≤ 1 кОм - - Икэ=100В, Rбэ≤ 1 кОм - - Икб=2 В, Iэ=1А 25

Таблица 2. Предельно допустимые электрические режимы КТ817

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер (Rэб ≤ 1кОм) КТ817A, A9	Uкэ max	В	40
КТ817Б, Б9			45
КТ817B, B9 КТ817Г, Г9			60 100
Напряжение эмиттер-база		В	5
Постоянный ток коллектора	Iк max A		3
Импульсный ток коллектора	Іки тах	Α	6
Максимально допустимый постоянный ток базы	Iб max	Α	1
Рассеиваемая мощность коллектора	Рк тах	Вт	25
Температура перехода	Тпер	°C	150